

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 1 1 月 8 日
Date of Application:

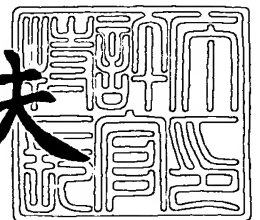
出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 3 2 5 1 7 0
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 3 2 5 1 7 0]

出 願 人 松 下 電 器 産 業 株 式 会 社
Applicant(s):

2 0 0 3 年 1 0 月 1 7 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 8 5 7 0 9

【書類名】 特許願

【整理番号】 2913040598

【提出日】 平成14年11月 8日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 H01H 38/13

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内

 【氏名】 水山 洋右

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内

 【氏名】 堀尾 英明

【発明者】

 【住所又は居所】 大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地 松下電器産業株式会社内

 【氏名】 松原 正吾

【特許出願人】

 【識別番号】 000005821

 【氏名又は名称】 松下電器産業株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100097445

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 岩橋 文雄

【選任した代理人】

 【識別番号】 100103355

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 坂口 智康

【選任した代理人】

【識別番号】 100109667

【弁理士】

【氏名又は名称】 内藤 浩樹

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 011305

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9809938

【書類名】 明細書

【発明の名称】 スイッチング素子

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 強誘電体素子を用いたスイッチング素子であって、強誘電体素子と、強誘電体素子に電界を与えるための複数の一对の電極とを含み、前記強誘電体素子が少なくとも二箇所のセグメントに分割され、隣接するセグメントにおける強誘電体素子の自発分極の方向が互いに概略反対方向であることを特徴とするスイッチング素子。

【請求項 2】 前記強誘電体素子が薄膜プロセスによって形成されることを特徴とする請求項 1 に記載のスイッチング素子。

【請求項 3】 前記強誘電体素子の両端の変位が固定されていることを特徴とする請求項 1 に記載のスイッチング素子。

【請求項 4】 前記一对の電極のうち、少なくとも一方の電極が、前記強誘電体の少なくとも二箇所のセグメントの位置に対応して形で分離していることを特徴とする請求項 1 に記載のスイッチング素子。

【請求項 5】 前記強誘電体素子が MgO 基板上に形成されることを特徴とする請求項 1 に記載のスイッチング素子。

【請求項 6】 前記強誘電体素子がシリコン基板上に形成されることを特徴とする請求項 1 に記載のスイッチング素子。

【請求項 7】 強誘電体素子を用いたスイッチングシステムにおいて、強誘電体素子と、この強誘電体素子に電界を印加するための複数の電極対と、この電極対に電力を供給するための電気配線と、アンテナと送受信用高周波回路を電氣的に接続させるための電極対と、前記強誘電体素子を含むスイッチング素子と前記高周波回路とを整合するためのカップラーと、を含み、前記強誘電体素子が少なくとも二箇所のセグメントに分割され、隣接するセグメントにおける強誘電体素子の自発分極の方向が互いに概略反対方向であることを特徴とするスイッチングシステム。

【請求項 8】 前記スイッチングシステムが高周波遮蔽材料によりパッケージングされたことを特徴とする請求項 7 に記載のスイッチングシステム。

【請求項 9】前記高周波遮蔽材料がガラスもしくは熔融シリカからなることを特徴とする請求項 7 に記載のスイッチングシステム。

【請求項 10】前記強誘電体素子が薄膜プロセスによって形成されることを特徴とする請求項 7 に記載のスイッチングシステム。

【請求項 11】前記強誘電体素子の両端の変位が固定されていることを特徴とする請求項 7 に記載のスイッチングシステム。

【請求項 12】前記一对の電極のうち、少なくとも一方の電極が、前記強誘電体の少なくとも二箇所のセグメントの位置に対応して形で分離していることを特徴とする請求項 7 に記載のスイッチングシステム。

【請求項 13】前記強誘電体素子が MgO 基板上に形成されることを特徴とする請求項 7 に記載のスイッチングシステム。

【請求項 14】前記強誘電体素子がシリコン基板上に形成されることを特徴とする請求項 7 に記載のスイッチング素子。

【請求項 15】強誘電体素子を用いたスイッチング素子であって、強誘電体素子と、強誘電体素子を含む第一の可動部と、第一の可動部と連結する 2 本からなつて対をなし、強誘電体素子を含む第二の可動部と、前記第一の可動部および前記第二の可動部に電界を印加するための複数の電極対とを含み、前記各々の可動部における強誘電体素子が、それぞれ少なくとも二箇所のセグメントに分割され、隣接するセグメントにおける強誘電体素子の自発分極の方向が互いに概略反対方向であることを特徴とするスイッチング素子。

【請求項 16】前記第一の可動部が、前記第二の可動部における最大変位部において、第二の可動部と連結することを特徴とする請求項 15 に記載のスイッチング素子。

【請求項 17】強誘電体素子を用いたスイッチングシステムであって、強誘電体素子と、強誘電体素子を含む第一の可動部と、第一の可動部と連結する 2 本からなつて対をなし、強誘電体素子を含む第二の可動部と、前記第一の可動部および前記第二の可動部に電界を印加するための複数の電極対と、これらの電極対に電力を供給するための電気配線と、アンテナと送受信用高周波回路を電氣的に接

続させるための電極対と、前記強誘電体素子を含むスイッチング素子と前記高周波回路とを整合するためのカップラーと、を含み、前記各々の可動部における強誘電体素子が、それぞれ少なくとも二箇所のセグメントに分割され、隣接するセグメントにおける強誘電体素子の自発分極の方向が互いに概略反対方向であることを特徴とするスイッチングシステム。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、マイクロマシンスイッチング素子に関し、ギガヘルツ以上の高い周波数帯域における、挿入損失の少ないスイッチング素子に関する。

【0002】

【従来の技術】

近年電気通信システム、特に移動電話もしくは無線セルラ電話の発展が著しい。たとえば、TDMA方式の通信システムにおいては、アンテナを介してGHz周波数帯域のRF信号の送受信が行われる。これらのシステムにおいては、通常、ひとつのアンテナが、送信段における出力と、受信段の入力のために、交互に使用される。したがって、このようなシステムにおけるスイッチに求められる性能は、接続時の電気抵抗が十分小さいこと、および、切断時の絶縁性が十分高いことである。電気抵抗が十分小さくなければ、ジュール熱による発熱によって挿入損失が生まれ、消費電力が大きくなる。また、絶縁性が低いと送受信の二つの回路の信号が干渉して、ノイズを発生してしまう。

【0003】

従来のスイッチング素子としては、たとえばPINダイオードを用いた電氣的なスイッチングシステムが使われている。ところが、このような半導体スイッチは、RF信号の周波数帯域が大きくなるほど電気抵抗が大きくなり、損失を招くことが分かっている。

【0004】

また、PINダイオードの損失は、実用的な2GHzの周波数において、1から1.5dB程度ある。また、絶縁性は40dB以上が望まれるのに対し、現状

のPINでは15～25 dB程度と不十分である。そのため、今後、さらに高周波数化していくことが予想されているこの分野の産業において、挿入損失が少なく、絶縁性の高いスイッチング素子が求められていた（例えば特許文献1を参照）。

【0005】

そこで、（特許文献1）の例に見られるようなマイクロマシンシステムを用いたスイッチング素子が提案された。この例においてはスイッチングは電氣的ではなく、機械的に行われるため、RF回路とのインピーダンスの整合がなされていれば、高い周波数帯域での損失や絶縁性が半導体スイッチに比較して、大きく改善される。

【0006】

しかしながら、この例に見られるような静電型のスイッチにおいては、機械的なスイッチングに必要な実用的な変位量をうるためには、数10 Vの電圧が必要である。通常、移動電話においては、5 V以下の電源が用いられているので、25～100 Vの電圧を得るには昇圧器が必要となり、サイズの増大、コストアップを招くという問題があった。

【0007】

そこで、静電型よりもはるかに小さな数Vの電圧でスイッチングに必要な変位を得ることができる圧電素子型が開発された（例えば特許文献2，特許文献3を参照）。この例においては、変位部の一端のみを機械的に拘束し、他端を自由端とする、いわゆる片持ち梁の形態が示されている。

【0008】

【特許文献1】

特開2000-348595号公報（第5頁、図1）

【特許文献2】

特開平11-340702号公報（第2～5図）

【特許文献3】

特開2000-348594号公報（図1）

【非特許文献1】

J. Appl. Phys. 22, Suppl. 2, 154 (1983)

【0009】

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、上述の（特許文献1～3）の例では、自由端が応力により反ってしまい、スイッチの平面度を損なうという、実用的な完成物を製作する際の課題を有していた。

【0010】

さらに、上述のような片持ち梁構成の圧電アクチュエータの欠点を改善するために、両持ち梁構成の圧電アクチュエータが自然に導かれる（例えば非特許文献1を参照）が、この構成においては、可動部の両端が固定されているために、ほとんど変位することができないということは自明である。

【0011】

これに対して（非特許文献1）においては、このような両持ち梁構成のアクチュエータの変位特性を改善するために、両端の固定方法に工夫が凝らされているが、この方法によって改善される変位量はさほど大きくないし、モーメントを発生させるための、固定端における接点は、ある程度の大きさを必要とし、現実的な試作も困難で、さらにコストアップを招くため、アクチュエータの量産には不向きである。

【0012】

本発明の目的は、上述したような従来の課題を解決するスイッチング素子を提供することである。

【0013】

【課題を解決するための手段】

そのため、本発明は、強誘電体素子を用いたスイッチング素子において、前記強誘電体素子が少なくとも二箇所のセグメントに分割され、隣接するセグメントにおける強誘電体素子の自発分極の方向が互いに概略反対方向であることを特徴とする。

【0014】

【発明の実施の形態】

この目的のために、本発明におけるスイッチング素子は、強誘電体素子を用いたスイッチング素子において、前記強誘電体素子が少なくとも二箇所のセグメントに分割され、隣接するセグメントにおける強誘電体素子の自発分極の方向が互いに概略反対方向であることによって特徴づけられる。

【0015】

本発明のひとつの形態においては、半導体プロセスにより成膜される P Z T 薄膜に弾性板と電極膜を重ねて成膜したユニモルフ型の圧電アクチュエータによってスイッチの主要部分が形成される。電極に電位差を与えることにより、P Z T 薄膜はその電界に応じて応力を発生する。発生した応力によりアクチュエータがどのように変位するかは、強誘電体素子の弾性定数、圧電定数、および弾性板の弾性定数、そして、アクチュエータにおける変位に対する境界条件によって異なる。本発明の好適な実施例を示すために、たとえば、次式の弾性コンプライアンス S 、圧電歪定数 d 、誘電率 ϵ 、によって表される P Z T 素子を用いた例について、図 1 を用いて説明する。

【0016】

このような圧電歪定数をもつ P Z T 素子を (001) 面を膜面として用いる。(001) 面と $x y z$ 座標軸における z 軸を同一方向に選ぶ。P Z T 素子をあらかじめ $+z$ 方向に分極処理しておくと、 $+z$ 方向に弾性板を重ねて形成した場合、 $+z$ 方向の電界の印加により x 方向における収縮を発生し、結果として $-z$ 方向への変位を生ずる。逆に $-z$ 方向の電界を印加すると x 方向において伸張を示し、結果として $+z$ 方向への変位を生ずる。このようにして、弾性板として適当な弾性定数をもつ材質を選択することにより、アクチュエータとして適量の変位を得ることが可能である。

【0017】

【数 1】

$$S = \begin{pmatrix} 0.1243 & -0.0438 & -0.0761 & 0 & 0 & 0 \\ -0.0438 & 0.1243 & -0.0761 & 0 & 0 & 0 \\ -0.0761 & -0.0761 & 0.1566 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.3399 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0.3399 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0.3382 \end{pmatrix} \times 10^{-10}$$

$$d = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -0.1360 \\ 0 & 0 & 0.1360 \\ 0 & 0 & 0.3370 \\ 0 & 0.5 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \times 10^{-9}$$

$$\varepsilon = \begin{pmatrix} 0.1692 & 0 & 0 \\ 0 & 0.1692 & 0 \\ 0 & 0 & 0.1571 \end{pmatrix} \times 10^{-7}$$

図 1 に示す例においては、強誘電体素子 2 3、および弾性板 2 2 が重ねて形成され、基板 6 上に固定部 2 6 によって固定されることにより、アクチュエータの一端が力学的に固定され、他端が自由であるような、いわゆる、片持ち梁構成のアクチュエータが形成される。電源 2 1 により強誘電体素子膜の両面に形成される電極膜（図示しない）を通じて、膜面に垂直な $-z$ 方向の電界を印加することにより、 x 方向における伸張を生じる。この伸張は一方の固定端の存在により、多端にモーメントを生じさせ、その結果、アクチュエータは図 1 のように変位する。このような変位の特徴は、可動部の両端が固定される両持ち梁構成においては、モーメントを発生することができないので現れない。

【0018】

ところで、強誘電体は、その特徴として、電界によって分極方向を変えること

ができる。はじめにある方向に分極処理された強誘電体に、その分極と反対方向の電界を与えると、ある大きさ以上の電界で強誘電体のグレインの分極方向がすべて反転することが知られている。この臨界電界は抗電界とよばれており、一般的に、数 kV/cm から 10 数 kV/cm の範囲である。したがって、抗電界による分極反転処理をほどこされた強誘電体を含むアクチュエータは前記の例と同方向の電界を印加すると、前記の例と全く反対の方向に変位する。そのときにアクチュエータに与える電界強度は抗電界より小さい値であることは言うまでもない。さもなければ、再び分極反転が起こり、もとの分極方向に戻ってしまうからである。

【0019】

そこで、本発明のひとつの形態においては、アクチュエータ両端における固定部が基板と連結するようにパターンニングされた両持ち梁構成の一本の可動部が設けられる。可動部は強誘電体素子膜、電極、弾性板、および絶縁層からなる。強誘電体素子膜を挟むように一对の電極が形成される。一对の電極のうちの少なくとも一方は、複数に分割・分離して形成される。実際のアクチュエータとして機能させるために、次の前処理を施す。すなわち、分割された電極のうち、隣接する電極の初期分極が概略反対になるような電界を与える。そのようにすることにより、強誘電体素子は分割された電極の形に対応した自発分極の反転分布を示す。この前処理の後、強誘電体素子全体に同一方向の電界を与える。

【0020】

図4に本発明におけるひとつの形態をあらわす斜視図を示す。アクチュエータ、すなわち可動部1は固定部26において基板6と連結する。基板6にはスペーサ14を介してRF信号ラインを含む上部基板15が密着する。上部基板15は高周波回路に連結する端子12と送受信アンテナ11を電氣的に接続するためのギャップ電極13を含む。

【0021】

図5は可動部1および固定部26を横切る断面を見た断面図である。可動部1の最上面はコンタクト電極31が形成されており、可動部1の変位によってコンタクト電極31がギャップ電極13のギャップに接触することにより、RF回路

とアンテナが短絡する。

【0022】

可動部 1 は強誘電体素子 23 とそれに電界を与えるための下部電極と上部電極から構成される。図 2 は下部電極を含む層を示す。下部電極 7 は可動部 1 と同じ形状にパターンニングされてひとつの電極を形成する。下部電極 7 は配線部を通じてコンタクト 3 と接続し、電源と電氣的に接続する。図 3 は上部電極を含む層を示す。上部電極は、可動部 1 の長手方向の概略 1/4 と 3/4 の位置で分割され、接地電極 10 および信号電極 9 を形成する。それぞれの電極は配線部を通じてコンタクト 4 および 5 と接続する。接地電極 10 と信号電極 9 は好ましくは絶縁層により被覆される。

【0023】

図 6 および図 7 に、前記前処理の方法について示す。下部電極 7 の上に強誘電体素子 23 が形成され、その上に上部電極 9 および 10 が形成され、その上にさらに、弾性板 22 が形成される。下部電極および上部電極 9 を接地し、上部電極 10 だけに正の電位をその電界強度が抗電界を超えるように印加する。GND はゼロ電位を、HIGH は正の電位を表す。このとき、上部電極 9 には上部電極 10 との境界近傍を除いてほぼ存在せず、上部電極 10 では電界 60 の方向は図面下方へ向くので、強誘電体素子 23 の分極方向 161 も下方を向く。

【0024】

次に、図 7 のように、下部電極、および上部電極 10 を接地し、上部電極 9 のみに負の電位を与える。LOW は負の電位を表す。このとき、上部電極 10 では、上部電極 9 との境界近傍以外では電界がほぼ存在せず、上部電極 9 では、電界 60 は図中上方を向くため、強誘電体 23 の分極方向 161 も上方を向く。

【0025】

以上が本発明における、強誘電体素子の前処理である。これにより、隣接する二つの電極 9 および 10 の形状に対応して、強誘電体素子 23 の自発分極の反転分布が得られる。この状態において、図 8 に示すように、下部電極を接地し、二つの上部電極はいずれも正の電位を与える。GND はゼロ電位を、HIGH は正の電位を表す。このとき上部電極 9 と下部電極 7 とに挟まれた空間においては、

強誘電体素子 23 の分極方向 161 が図中上向きであり、電界 60 が下向きであるので、強誘電体素子は伸張を呈し、下に凸な形に変形する。一方、上部電極対 10 と下部電極 7 に挟まれた空間においては、強誘電体素子 23 の分極方向 161 が図中下向きであり、電界 60 が下向きに与えられるので、強誘電体素子 23 は収縮を呈し、上に凸な形に変形する。両方の効果が組み合わさり、全体として最大高さを持つように変位部が変形する。

【0026】

このようにすると、変位部の概略中央部に変曲点が形成されることから、最大変位の部分がほぼ水平となるという効果を有する。この特徴は、高周波回路とアンテナを短絡しようとするときに、最大変位部とギャップ電極との、より良好な接触を実現するという利点をもたらす。

【0027】

このように、本発明は、変位部の両端が固定されているため、膜状の変位部を形成しても、片持ち梁構成では課題であった膜反りが抑制されると同時に、片持ち梁構成のスイッチと同様な変位量を得ることができるという効果を有する。さらに、本発明は、変位部に変曲点を持つことから、RF 回路の短絡部におけるより良好な接触を実現するという効果を有する。

【0028】

本発明の別の形態においては、前記変位部を 3 つ組み合わせてさらに、変位量を大きくすることができる。図 11 にこの別の形態におけるスイッチング素子の斜視図を示す。第一の変位部 1 は 2 本からなる第二の可動部 61 および 62 の概略中央で第二の可動部 61 および 62 と連結する。固定部 26 は第二の可動部 61 および 62 のみに設けられ、基板 6 と連結する。

【0029】

図 9 に下部電極層を示す。下部電極 7 はひとつで形成される。図 10 に上部電極層を示す。上部電極は前記の形態と同様に、二つの電極 9 および 10 から構成される。上部電極 9 および 10 は絶縁のために分割・分離されて、望ましくは絶縁層を被覆されて隣接する。上部電極 9 および 10 はそれぞれの可動部 1、61、および 62 において、前記の形態と同様にそれぞれ概略長さ $1/4$ と $3/4$ の

位置で分割される。この形態においては、第二の可動部の概略中央部において、第一の可動部が接続するため、第一の可動部の最下点が第二の可動部の最大変位部となる。すなわち、第一の変位部は第二の変位部の最高点から相対的に変位する。従って、第一の変位部の基板からの絶対変位量は第二の変位部を持たない場合よりも、さらに大きくなるという効果がある。

【0030】

本発明の別の形態においては、前記強誘電体素子が薄膜プロセスによって形成されることを特徴とする。強誘電体素子が薄膜であることにより、低い電圧でも高い電界強度を得ることが可能となり、特に携帯電話に用いる際に通常要求される低電圧駆動の条件を満たすという長所をもつ。また、薄膜プロセスを用いることにより、同様に要求される小型化、低価格化をも同時に満足する。

【0031】

【実施例】

（実施例1）

本発明の好適な実施例を図5、6、および7を用いて以下に説明する。単結晶MgO基板6上にPt層の下部電極7、8、およびコンタクト2、3をフォトリソグラフィによりパターンニングし、その上に強誘電体素子としてPLT/PZT薄膜23を1 μ m成長させた。続いて、Cr層の上部電極9、10およびコンタクト5、4を形成した。絶縁層としての機能を兼ね備えるSiO₂層の弾性板22を1 μ m成膜し、最後にRF回路とアンテナを短絡させるための接触電極13をTi層により形成した。PZT層の可動部を形成するために、MgO基板を熱燐酸によりエッチングし、キャビティ65を形成した。

【0032】

アクチュエータの形状として、図4に示すような、ただ一つの可動部をもつものを、上記方法によって作製した。素子外寸は1mmの正方形で、可動部は長さ0.8mm、幅0.1mmとなるよう形成した。このアクチュエータにおいて、上部および下部電極に3Vの電圧を印加して、レーザードップラー装置により、その最大変位を計測した。その結果、変位部中央において約4.4 μ mの最大変位を得た。最大変位までの応答速度はおよそ40 μ sであった。挿入損失は周波

数が 2 GHz において約 0.2 dB、20 GHz において約 0.5 dB であった。アイソレーションは周波数 2 GHz において約 50 dB、20 GHz において約 40 dB であった。

【0033】

(実施例 2)

別の実施例として、図 8 に示すような、二つの可動部をもつものを、上記と同様な方法によって作製した。弾性板には 1 μ m 厚のポリイミドを用いた。素子外寸は 1 mm の正方形で、可動部は長さ 0.8 mm、幅 0.1 mm とした。第一の可動部は一对の第二の可動部の中央部で連結するようにパターンニングした。このアクチュエータにおいて、上部および下部電極に 3 V の電圧を印加したところ、第一の可動部の中央部において、6.5 μ m の最大変位を得た。応答速度はおよそ 60 μ s であった。挿入損失は周波数が 2 GHz において約 0.2 dB、20 GHz において約 0.5 dB であった。アイソレーションは周波数 2 GHz において約 50 dB、20 GHz において約 40 dB であった。

【0034】

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によるスイッチング素子は、従来、半導体スイッチにおいて課題であった、高周波帯域での挿入損失を低減することを可能とする。また、本発明は、従来のマイクロマシンスイッチにおいて課題であった、膜反りの解決と変位改善という両立しない課題を一度に改善する効果を有する。さらに、本発明は、アクチュエータに変曲点を持たせることにより、スイッチ接点における良好な接触をもたらし、低い電気抵抗有するという効果を有する。

【0035】

なお、上記の例は、好適な例を示したにすぎず、本発明による電界印加方法は、いかなる形状のアクチュエータにも適用可能である。また、電界印加方法は直流であっても交流であってもよい。下部電極は共通のひとつの電極で構成される必要はなく、上部電極と同様の形状で分割されていてもよい。さらに、下部電極が分割され、上部電極が共通のひとつの電極で構成されてもよい。

【0036】

さらに、強誘電体素子としては上記のような材質で圧電パラメータをもつものを選んだが、どのような圧電材料であっても、どのような圧電パラメータであっても、電界方向の正しい選択により、同様の効果が得られることは言うまでもない。さらに、弾性板の選択もスイッチの設計によって任意であって、強誘電体素子との適当な組み合わせにより、上記と同様な効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

従来のスイッチング素子斜視図

【図 2】

本発明による電界印加用電極（下部電極）の正面図

【図 3】

本発明による電界印加用電極（上部電極）の正面図

【図 4】

本発明によるスイッチング素子斜視図

【図 5】

本発明によるスイッチング素子断面図

【図 6】

本発明によるスイッチング素子の変位状態を表す断面図

【図 7】

本発明による別の形態におけるスイッチング素子の正面図

【図 8】

本発明による別の形態におけるスイッチング素子の斜視図

【図 9】

本発明による別の形態におけるスイッチング素子の平面図

【図 10】

本発明による別の形態におけるスイッチング素子の平面図

【図 11】

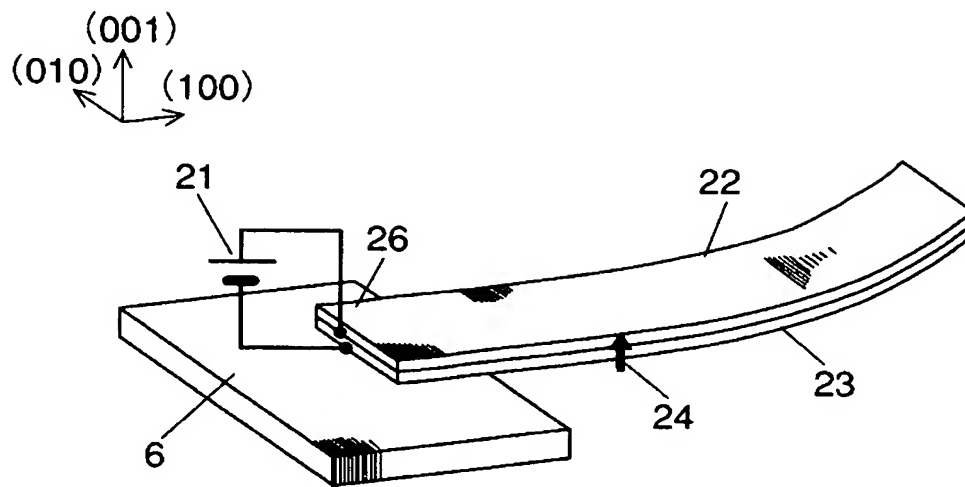
本発明による別の形態におけるスイッチング素子の斜視図

【符号の説明】

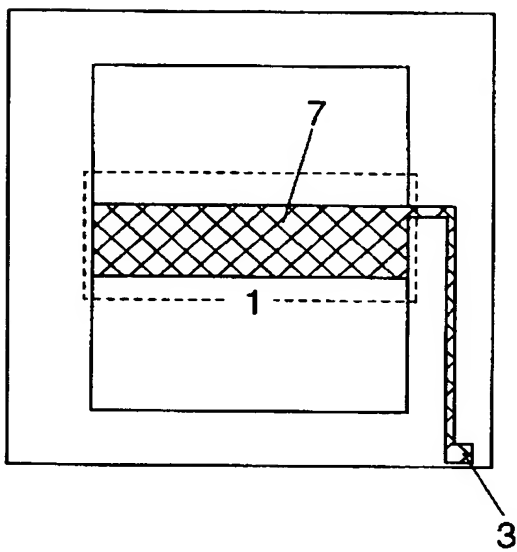
- 1 可動部（第一の可動部）
- 2 下部電極におけるLOW電極のコンタクト
- 3 下部電極におけるHIGH電極のコンタクト
- 4 上部電極におけるLOW電極のコンタクト
- 5 上部電極におけるHIGH電極のコンタクト
- 6 基板
- 7 下部電極におけるLOW電極
- 8 下部電極におけるHIGH電極
- 9 上部電極におけるHIGH電極
- 10 上部電極におけるLOW電極
- 11 アンテナ
- 12 RF回路への端子
- 13 ギャップ電極
- 14 スペーサ
- 15 上部基板
- 21 電源
- 22 弾性板
- 23 強誘電体素子
- 24 分極方向
- 26 固定部
- 31 コンタクト電極
- 60 電界
- 61 第二の可動部
- 62 第二の可動部
- 63 引出し線
- 64 引出し線
- 65 キャビティ
- 161 分極方向

【書類名】 図面

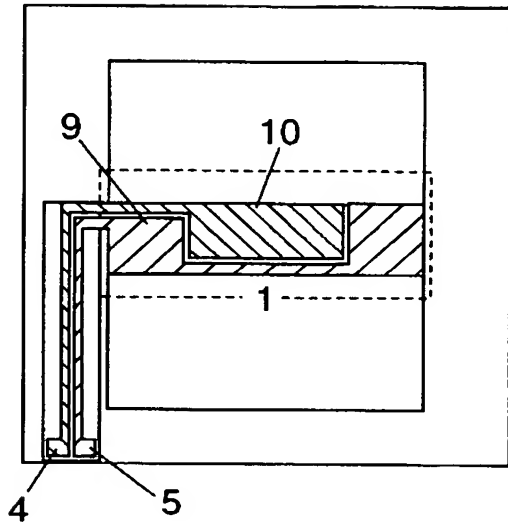
【図 1】



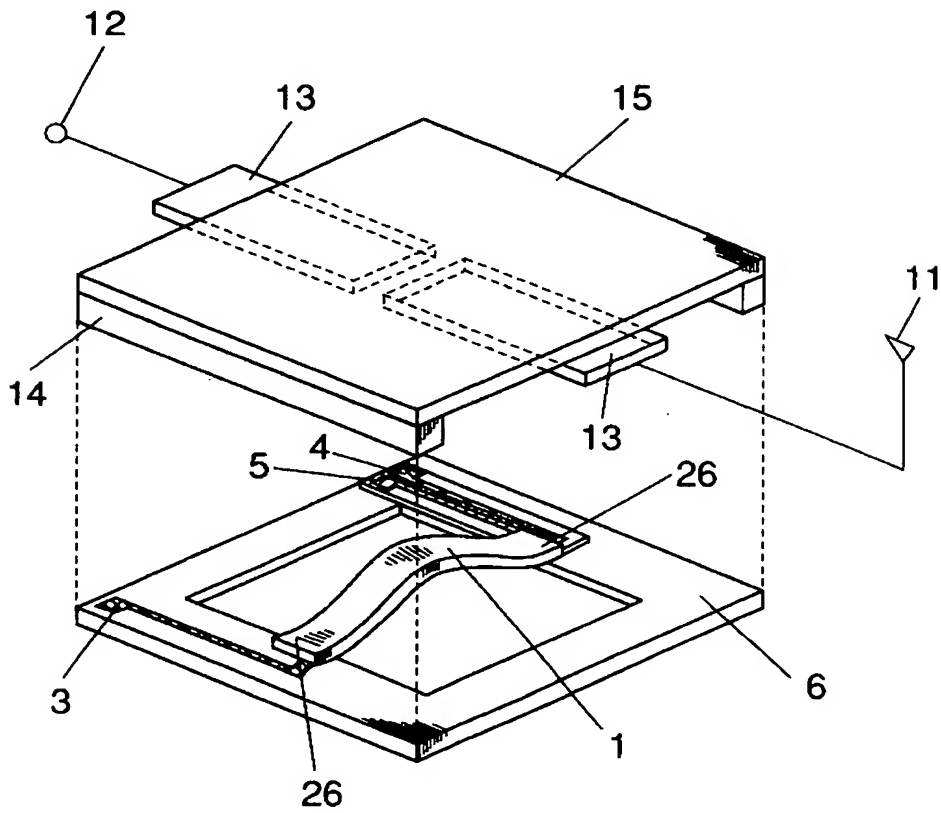
【図 2】



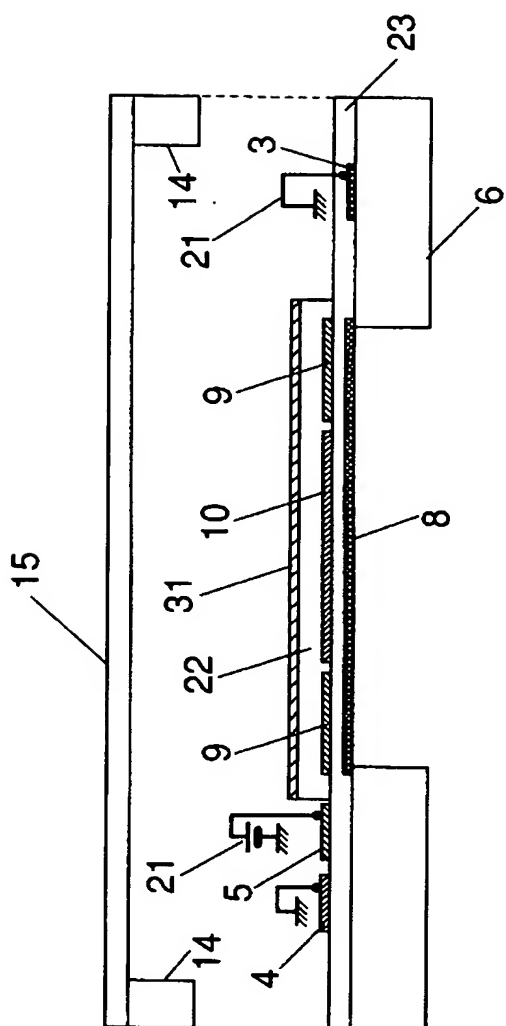
【図 3】



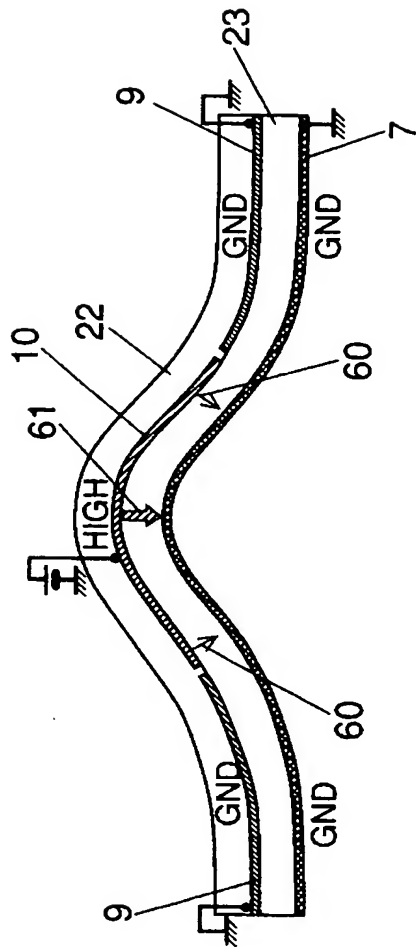
【図 4】



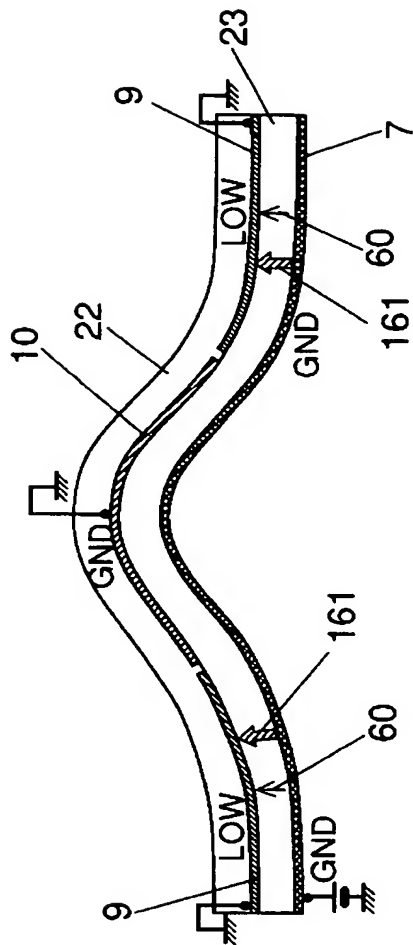
【図 5】



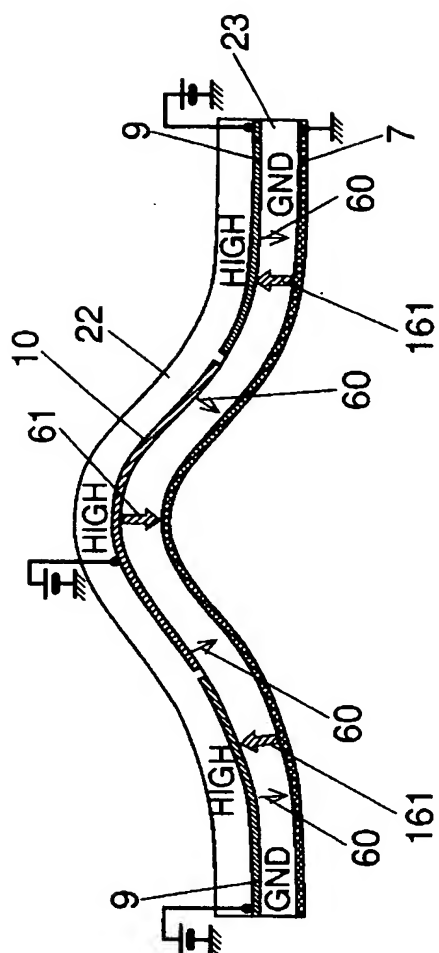
【図 6】



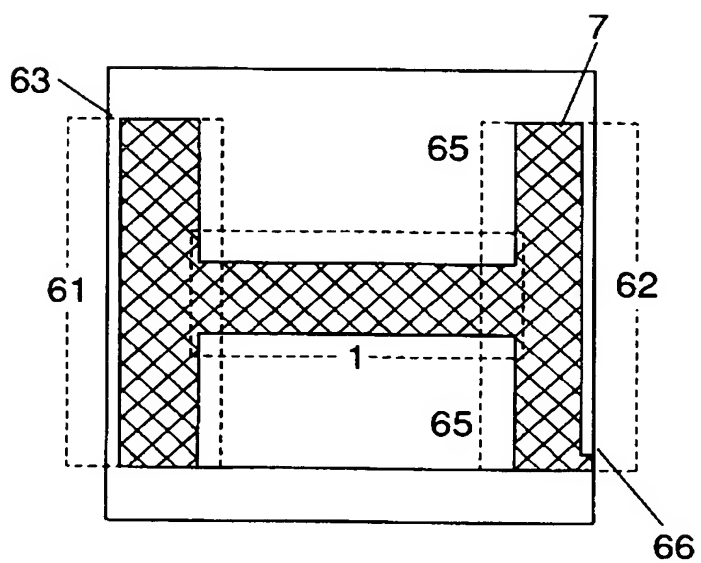
【図 7】



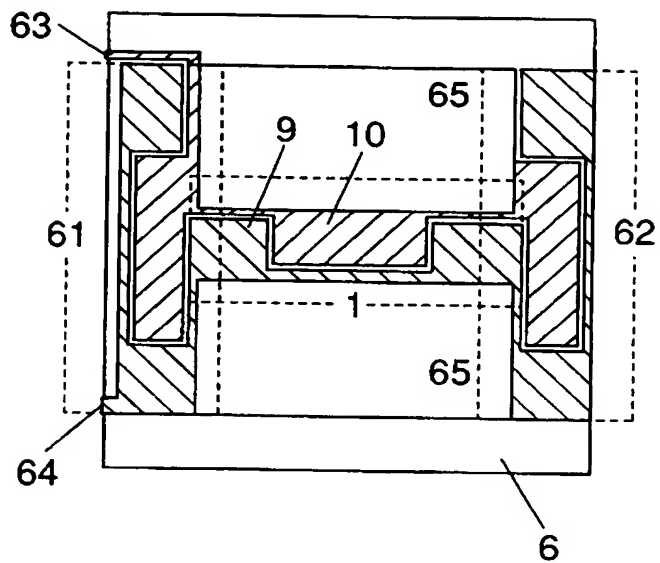
【図 8】



【図 9】



【図 10】



【書類名】 要約書**【要約】**

【課題】 従来の半導体型 R F スイッチにおいては、高い周波数帯域において、求められる挿入損失と絶縁性を満足していなかった。また、従来の静電型 R F スイッチにおいては、挿入損失は小さいが、機械的なスイッチングに必要な実用的な変位量をうるためには、数 10 ～ 100 V の電圧が必要であり、コストアップの問題があった。さらに、従来の圧電型 R F スイッチは、低電圧で挿入損失が小さいが、素子の反り量が大きいという問題、および変位量が小さいという課題を有していた。

【解決手段】 本発明は、圧電素子を用いた R F スイッチにおいて、強誘電体素子を用いた R F スイッチにおいて、前記強誘電体素子が少なくとも二箇所のセグメントに分割され、隣接するセグメントにおける強誘電体素子の自発分極の方向が互いに概略反対方向であることを特徴とする。

【選択図】 図 4

特願 2 0 0 2 - 3 2 5 1 7 0

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 5 8 2 1]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 8 日

[変更理由]

新規登録

住 所

大阪府門真市大字門真 1 0 0 6 番地

氏 名

松下電器産業株式会社